

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【公開番号】特開2007-42671(P2007-42671A)
【公開日】平成19年2月15日(2007.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-006
【出願番号】特願2005-221902(P2005-221902)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

シリコン基板上に選択的にシリコンエピタキシャル膜を成長させる基板処理装置であって、

処理室と、

前記処理室内に收容される前記基板を加熱する加熱装置と、

前記処理室内にシリコン系ガスおよびエッチング系ガスを供給するガス供給系と、

を有し、

前記ガス供給系は、前記シリコン系ガスまたは前記エッチング系ガスを前記処理室内の長さの異なる複数箇所へ供給する複数のガス供給部材を備えたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記シリコン系ガスまたは前記エッチング系ガスを前記処理室内の長さの異なる複数箇所へ供給する場合には、同じノズルを使用することを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記処理室には複数の基板が積層された状態で收容され、

前記加熱装置は個々に異なる加熱制御を行うことができる複数の分割ゾーンを備え

、

前記分割ゾーンによる加熱領域は、前記基板の積層方向に亘って分割され、

前記分割ゾーンのそれぞれの温度設定値が略同一であることを特徴とする請求項1

または2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記シリコン系ガスと前記エッチング系ガスとを交互に繰り返して前記処理室内に供給して、

前記基板上にシリコンエピタキシャル膜を選択成長させることを特徴とする請求項1乃至3に記載の基板処理装置。